

majkusiak

BOGDAN MAJKUSIAK

Bogdan Majkusiak urodził się 16 lutego 1955 roku w Warszawie. W 1974 roku ukończył Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Warszawie i rozpoczął na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej studia na specjalności Technologia Elektronowa. Ukończył je z wyróżnieniem w 1979, roku uzyskując tytuł magistra inżyniera elektronika. Również na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskał w 1985 roku stopień doktora nauk technicznych za rozprawę *Stałoprądowy model diody tunelowej MIS (metal–ultracienki dielektryk–półprzewodnik)* (z wyróżnieniem) i w 1991 roku stopień doktora habilitowanego za rozprawę *Bardzo cienki tlenek bramkowy w tranzystorze MOS: konsekwencje dla działania i modelowania*. W 2003 roku uzyskał tytuł naukowy profesora. Od 1978 roku jest zatrudniony w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki, od 1995 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Odbił półroczne staże naukowe w Instytucie Technologii Elektronowej CEMI (1985) i Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA (1992).

Zainteresowania badawcze Bogdana Majkusiaka dotyczą teorii, charakteryzacji i modelowania przyrządów półprzewodnikowych mikroelektroniki, ze szczególnym ukierunkowaniem na konsekwencje zjawisk kwantowo-mechanicznych ujawniających się w przyrządach typu MOS i MOS/SOI o bardzo małych rozmiarach, a także zjawisk fizycznych i przyrządów nanoelektroniki. W jego dorobku naukowym znajdują się prace dotyczące teorii i modelowania prądu tunelowego w układzie metal–dielektryk–półprzewodnik (MOS) oraz opracowanie i doświadczalnie zweryfikowa-



nie modeli teoretycznych diod tunelowych MOS i MOS/SOI, przyrządów przełączającego MOS(np), tranzystora tunelowego MISIM, a także zbadanie konsekwencji tunelowania przez ultracienki dielektryk bramkowy oraz kwantowania energii nośników w przypowierzchniowym obszarze półprzewodnika na pracę tranzystorów MOS i MOS/SOI. Do tego obszaru tematycznego należą również prace dotyczące transportu w dwuwymiarowym gazie elektronowym powstającym w kanale tranzystora MOS. W zakresie charakteryzacji struktur MOS jest on autorem oryginalnych metod określania grubości dielektryka bramkowego w strukturze MOS oraz ruchliwości przypowierzchniowej nośników i różnicy prac wyjścia metal–półprzewodnik w tranzystorze MOS. Prace badawcze prowadził w ramach wielu projektów badawczych krajowych Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i międzynarodowych Unii Europejskiej. Wyniki swych prac przedstawił w licznych naukowych artykułach i komunikatach konferencyjnych. Za osiągnięcia nauko-

Słowa kluczowe

- mikroelektronika
- nanoelektronika
- przyrządy półprzewodnikowe

M

we otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wielokrotnie Nagrodę Rektora Politechniki Warszawskiej.

Tematykę swych prac badawczych wprowadzał do dydaktyki, opracowując i uruchamiając oryginalne wykłady: „Fizyczne podstawy przetwarzania informacji”, „Podstawy fizyczne nanoelektroniki”, „Charakteryzacja struktur i technologii mikroelektronicznych”. Prowadził też wykłady z zakresu podstaw elektroniki półprzewodnikowej i przyrządów półprzewodnikowych, w języku polskim i w języku angielskim.

Pracę naukową i dydaktyczną łączył z intensywną działalnością organizacyjną. W latach 1993–1996 był członkiem Rady Programowej i członkiem Komisji ds. Studiów w Języku Angielskim, w latach 1996–1999 koordynatorem Rad Programowych na Wydziale

Elektroniki i Technik Informatycznych, od 1996 roku członkiem Komisji ds. Kształcenia, od 1999 roku członkiem Senackiej Komisji ds. Badań Naukowych, był też członkiem lub przewodniczącym licznych komisji doradczych. W latach 1993–1996 był kierownikiem specjalności Mikroelektronika. W latach 1996–1999 pełnił na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych funkcję prodziekana ds. nauczania, a w kadencji 1999–2002 funkcję prodziekana ds. ogólnych. W 2010 roku został kierownikiem specjalności *Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie*. Był członkiem komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji, jak np.: INFOS 2005 w Leuven, INFOS 2007 w Atenach, INFOS 2009 w Cambridge, INFOS 2011 w Grenoble, IWCE 2010 w Pizie.

Jest żonaty, ma dwóch synów.

